

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. ۱۳۹۷ بهمن ۱۳۹۷



# تولید پلاسمونیکی نور لیزری با طولموج کوتاه با استفاده از نانوساختارپاپیونی شکل طلای روکشدار مستقر روی زیر لایه

محمد سليماني، مسعود محبي، محمدرضا فروزش فرد

گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر، رفسنجان m.mohebbi@vru.ac.ir

چکیده – ما تولید هارمونیک مرتبه بالا ناشی از برهم کنش گاز هیدروژن با میدان الکتریکی تقویت شده به وسیلهی پلاسمون سطحی موضعی را بررسی می کنیم. این میدان ها زمانی که یک نانوساختار پاپیونی شکل طلای روکش دار که روی یک زیرلایه از جنس YAG قرار دارد در معرض یک موج تخت کوتاه مدت با طول موج بلند قرار می گیرد تولید می شوند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با به کار بردن همزمان پوشش عایق نازک اطراف نانو ساختار و زیر لایه، تقویت میدان در گاف نانوساختار به حدی است که می توان به تولید هارمونیک مرتبه بالاتر دست یافت. با ایس پیشنهاد، از تخریب نانوساختار جلوگیری می شود و درنتیجه می توان از ساختار، برای دفعات زیاد جهت تولید هارمونیک استفاده کرد.

كليد واژه- هارمونيك مرتبه بالا، ميدان الكتريكي تقويتشده، نانوساختار، پلاسمون سطحي موضعي

# Plasmonic Production of Short-wavelength Laser Light Using a Coated-Gold Bow-tie Nanostructure placed on Substrate

### Soleimani Mohammad, Mohebbi Masoud, Forouzeshfard Mohammad Reza

### Department of Physics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan

Abstract- We investigate high-order harmonic generation resulting from the interaction of Hydrogen gases with Enhanced electric field based on Localized surface plasmon. These fields produced when a coated-gold bow-tie nanostructure on a sublayer is illuminated by a short planner wave of long wavelength. The simulation results show that by simultaneously applying a thin insulated coating around the nanostructure and substrate, the field strength in the nanostructure gap is such that the higher order harmonic generation can be achieved. By this offer can be prevented nanostructure from destruction, and results that one can be apply to produce harmonics for many times.

Keywords: High-order Harmonic, Enhanced electric field, Nanostructure, Localized surface plasmon

#### مقدمه

توليد هارمونيک مرتبه بالا زماني رخ مي دهد که اتمها و مولکول های گاز و یا جامدات کریستالی تحت تابش پالس ليزرى شديدى قرار گيرند. اين فرآيند غيرخطى باعث تولید تابش فرابنفش دور (XUV) و اشعه X نرم از پالس لیزری فمتوثانیه با طول موجی در محدوده طیف مرئی و یا مادون قرمز می شود. پالس لیزری مورد استفاده در فرآیند تولید هارمونیک مرتبه بالا باید دارای شدتی از مرتبه 10 TW cm<sup>-2</sup> باشد. بنابراین یک تقویت یالس بر مبنای چرپ[۱] برای بالا بردن قله توان پالس فمتوثانیه لازم می باشد. اخیرا با استفاده از تشدید پلاسمون سطحی در نانو ساختار پاپيوني شكل فلزي، ميدان الكتريكي فرودي تا بیش از dB 20 تقویت می شود [۲] درنتیجه شدت پالس لیزری از آستانه موردنیاز برای تولید هارمونیک مرتبه بالا تجاوز كرده البته نرخ تكرار پالس ثابت باقى مىماند و ديگر نیازی به فرآیند تقویت لیزری نیست. نیمرخ طیفی هارمونیکهای مرتبه بالای تولیدشده توسط میدان پلاسمونیکی تقویتشده تعیین می شود. لذا پژوهش های زیادی برای بهبود کنترل طیف هارمونیکهای تولیدی انجام شده است [۳-۵]. تاکنون نانو ساختارهای استفاده شده در این فرآیند دارای دو ضعف اصلی میباشند اول مقاومت کم در برابر آسیبهای حرارتی ناشی از پالس لیزری (که با تغییر شکل و یا تبخیر نانو ساختار) باعث كاهش طول عمر نانو ساختار مى شود[8]. ضعف دوم نانو ساختارها نقاط داغ (ناحیه فضایی که شدت میدان الکتریکی به بیشترین مقدار خود می رسد) به شدت باریک و محدود هستند [٧]. در این مقاله برای حل این مشکل، استفاده از یک لایهی عایق نازک حول نانو ساختار پیشنهاد داده می شود که نهتنها از تخریب نانو ساختار جلوگیری میکند بلکه باعث کاهش میدان تقویتشده درون گاف نانوساختار به مقدار زیادی نمی شود. در نتیجه در قیاس با تولید باریکه لیزری با کوتاهترین طول موجی که

کیم و همکارانش [۲] به صورت تئوری و تجربی به آن دست یافته بودند، با این پیشنهاد که در این مقاله ارایه میدهیم میتوان به تولید باریکه لیزری با طول موج کوتاهتر نیز دست یافت. همچنین در این مقاله، به منظور عینیت بخشیدن به استفاده از چنین ساختاری در آزمایشگاه، یک زیر لایه در زیر نانو ساختار با روکش عایق قرار داده شد. در ادامه بر پایه شبیه سازی عددی، به بررسی تأثیر قرار دادن این زیر لایه بر تقویت میدان و طیف هارمونیک تولیدی پرداخته می شود.

## شبيەسازى

در این قسمت مطابق شکل (۱) با استفاده از نرمافزار کامسول یک نانوذره پاپیونی شکل از جنس طلا با زاویه رأس  $\theta = 10$ ، ارتفاع h = 275 nm، ضخامت t = 25 nmگاف d = 10 nm و با روکش عایق به ضریب شکست ۱٫۴۶ و ضخامت ۲ نانومتر که بر روی یک زیر لایه به ضریب شکست ۱٫۸۳ و ضخامت ۲۵ نانومتر درون یک مکعب مستطیل از جنس هوا قرار دارد شبیه سازی می کنیم.



شکل ۱: شکل سهبعدی نانو ساختار متشکل از دو مثلث از جنس طلا (رنگ بنفش) با روکش عایق (رنگ سفید) روی یک زیر لایه از جنس YAG (رنگ زرد).

لازم به ذکر است که مشخصات هندسی نانوذره تحت بررسی، بعد از بهینهسازی توسط نرمافزار کامسول به دستآمدهاند که در ازای این مقادیر بهینه از پارامترهای هندسی (مقادیری که در بالا اشاره شد) بیشترین تقویت میدان الکتریکی درون گاف نانو ساختار به دست میآیند. یک موج الکتریکی تخت از سطح بالایی مکعب، با طول موج ۸۰۰nm و با قطبش الکتریکی در راستای محور

x که در راستای z منتشر می شود به نانو ساختار تابیده می شود و توزیع ضریب میدان الکتریکی پراکنده شده (نسبت اندازه میدان الکتریکی پراکنده شده به اندازه میدان فرودی) برای حالت نانو ساختار با روکش عایق و زیر لایه در شکل (۲) گزارش شده است.



شکل ۲: توزیع دوبعدی میدان الکتریکی تقویتشده در اطراف نانو ساختاری از جنس طلا با روکش عایق و روی زیر لایه از جنس YAG در صفحههای xz،yz و xx که از مرکز گاف نانو ساختار عبور میکنند.

با مقایسه مقدار تقویت میدان الکتریکی در صفحههای xy، xz و yz درمییابیم بیشترین تقویت در ناحیه فضای خالی بين نوك مثلثها (گاف نانو ساختار) اتفاق مى افتد. بنابراین در گام بعد توزیع یک بعدی میدان الکتریکی تقویتشده روی خط واصل بین دو رأس نانو ساختار را مطابق با شکل (۳) برای تمامی حالتهای نانو ساختار بدون روکش عایق، با روکش عایق، با روکش عایق و زیر لايه نشان داده مي شود. مطابق شكل بيشترين تقويت میدان فرودی برای حالت نانوساختار طلای بدون روکش طلا و زیر لایه برابر با مقدار تقریبی ۴۸۰ برابر بر روی نوک مثلثها و ۱۸۰ برابر در وسط گاف (x=y=z=0) می باشد. با اضافه کردن فقط لایهی روکش مقدار تقویت به مقدار تقریبی ۱۰ برابر بر روی نوک مثلثها و مقدار تقریبی ۳ برابر در وسط گاف کاهش می یابد. با اضافه کردن یک زیر لایه به نانوساختار طلای روکشدار، مقدار تقویت به مقدار تقریبی و ثابت ۳ برابر در سرتاسر گاف کاهش می یابد.



شکل ۳: توزیع یک بعدی میدان الکتریکی تقویت شده روی خط واصل بین دو رأس نانو ساختار (z=0) برای حالت های نانو ساختار بدون روکش عایق، با روکش عایق، با روکش عایق و زیر لایه

# توليد هارمونيک مرتبه بالا

درنهایت با قرار دادن یک اتم هیدروژن در وسط گاف (بهعنوان مثال بر روی وسط خط واصل بین دو رأس) نانو ساختار میتوان به بررسی پاسخ غیرخطی این اتم به میدان تقویتشده پرداخت [۸, ۹]. دینامیک حرکت یک الکترون که در یک میدان الکتریکی با قطبش خطی (درون گاف بر روی خط 0=z) مطابق با شکل (۳) حرکت میکند را میتوان با تقریب خوبی از حل معادله شرودینگر دارد پرداخته شد تا امکان واقعی تولید هارمونیک مرتبه بالا در آزمایشگاه میسر شود. وجود لایه عایق از تخریب نانوساختار جلوگیری میکند و با این چیدمان میتوان یک منبع لیزری طول موج کوتاه و با قابلیت استفاده طولانی در اختیار داشت.

#### مرجعها

[1] J. Seres, E. Seres, A. J. Verhoef, G. Tempea, C. Streli, P. Wobrauschek, V. Yakovlev, A. Scrinzi, C. Spielmann, F. J. N. Krausz, "Laser technology: source of coherent kiloelectronvolt X-rays", Nature, Vol.433, pp. 596, 2005.

[2] S. Kim, J. Jin, Y.J. Kim, I.Y. Park, Y. Kim, S.W. J. N. Kim, "High-harmonic generation by resonant plasmon field enhancement", Nature, Vol.453, pp. 757, 2008.

[3] H. Ebadian, M. Mohebbi, "Plasmonic nanostructure assisted HHG in NIR spectrum and thermal analysis", Appl. Phys., Vol.51, pp.8, 2018.

[4] H. Ebadian, M. Mohebbi, "Strong electric field enhancements in asymmetric metallic nanostructures and high-order harmonic generation", Appl. Opt., Vol.55, 2016.

[5] Pfullmann, N. et al, "Nano-antennae assisted emission of extreme ultraviolet radiation," Annalen der Physik, Vol.526, 2014.

[6] I. Y. Park, J. Choi, D. H. Lee, S. Han, S. Kim, S. W. J. A. d. P. Kim, "Generation of EUV radiation by plasmonic field enhancement using nano-structured bowties and funnel-waveguides", Ann. Phys., Vol.525, pp. 87-96, 2012.

[7] M. Sivis, M. Duwe, B. Abel, C. J. N. P. Ropers, "Extreme-ultraviolet light generation in plasmonic nanostructures", Nature, Vol.9, pp. 304, 2013.

[8] C. Winterfeldt, "Generation and control of high-harmonic radiation", Würzburg university, 2006.

[9] M. F. Ciappina, J. Pérez-Hernández, L. Roso, A. Zaïr, M. Lewenstein, "High-order harmonic generation driven by plasmonic fields: a new route towards the generation of UV and XUV photons", in Journal of Physics: Conference Series (IOP Publishing), pp. 012001, 2015.

[10] Masoud Mohebbi and Sakineh Nazarpoor Malaei, "Electron path control of high-order harmonic generation by a spatially inhomogeneous field", Modern Optics, Vol. 63, No. 7, pp. 643–652, 2016. وابسته به زمان یکبعدی به دست آورد. بر این مبنا می توان شدت هارمونیکهای مر به بالای گسیل شده را محاسبه کرد [۱۰]. در شکل (۴) طیف هارمونیکهای مر تبه بالا برای موردهای فقط نانو ساختار طلا، نانو ساختار طلا با روکش عایق و نانوساختار طلا با روکش عایق مستقر بر زیر لایه نشان داده

شده است. شدت میدان فرودی $W/\,{
m cm}^2$  و مدت  $5 \times 10^{11} {
m W}/\,{
m cm}^2$  و مدت تپش  $10 \, f s$  در نظر گرفتهشده است.



شکل ۴: طیف هارمونیکهای مرتبه بالا برای موردهای فقط نانو ساختار طلا (قرمز)، نانو ساختار طلا با روکش عایق (سبز) و نانوساختار طلا با روکش عایق مستقر بر زیر لایه (آبی نقطهچین).

مرتبه فرکانس قطع برای حالت نانوساختار طلا با روکش عایق مستقر بر زیر لایه که قابلیت پیاده کردن آزمایشگاهی دارد حدود ۳۴ می باشد. در دو حالت دیگر فرکانس قطعی به علت تقویت زیاد (که منجر به تخریب ساختار در واقعیت می شود) مشاهده نمی شود.

### نتيجهگيرى

در این پژوهش به بررسی طیف هارمونیک ناشی از اتم هیدروژن درون گاف نانوساختار پاپیونی شکل از جنس طلا و با روکش عایق که روی زیر لایه از جنس YAG قرار